



粉体用ALD装置のご紹介
“Tiビーズへの成膜”

2016年10月27日
(株)菅製作所

Copyright 2016 © All rights reserved, SUGA Co., Ltd

CONFIDENTIAL

▽ TiビーズへのAl₂O₃成膜結果

成膜条件

使用装置:SAL1000B

基板回転:On

振動:On

装置角度:約8度

基板温度:350°C

試料:Φ300um Tiビーズ

H₂O開時間:15msec

H₂O後Wait時間:15sec

TMA開時間:15msec

TMA後Wait時間:10sec

繰返し回数:1150cycle



SAL1000B 粉体用ALD装置



成膜前



成膜後
(色から膜厚200nm程度と推定)

▽ TiビーズへのAl₂O₃成膜結果(EDS Mapping)JED-2200 測定結果
JED-2200 测定结果